Catálogo de productos

Amplificadores de potencia LDMOS

Los amplificadores LDMOS utilizan transistores MOS de difusión lateral para aumentar la potencia RF. Adaptación, polarización, picos de señal y trayectoria térmica completa determinan los límites de funcionamiento.



Productos: 2

Revisión: 2 · Fecha de revisión: 2026-11-11



LCPAM-20-520-200A

Módulo amplificador de potencia RF LDMOS de 20–520 MHz, 200 W saturados

El módulo con etapa final LDMOS cubre 20–520 MHz con 200 W de potencia saturada típica. La salida en compresión de 1 dB se especifica aparte en 50 W típicos, con ganancia de pequeña señal típica de 53 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidad: MHz

Potencia RF de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 200; Unidad: W

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 50; Unidad: W

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: G; Típico: 53; Unidad: dB

25 °C; 50 Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-20-520-350

Amplificador LDMOS RF de 20–520 MHz, salida saturada típica 350 W

El amplificador LDMOS cubre 20–520 MHz con salida saturada típica de 350 W y salida típica de 150 W en compresión de 1 dB. La ganancia típica es 56 dB, con corriente típica 29 A a 350 W y alimentación típica 48 VDC.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 150; Unidad: W

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 350; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 56; Unidad: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.